



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HS2236

对应国外型号
2SC2236

主要用途

音频放大

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极功率耗散 ($T_c=25$).....	900mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	30V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	30V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	5V
I_C	——集电极电流.....	1.5A
I_B	——基极电流.....	0.15A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	30			V	$I_C=10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=1mA, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{CB}=30V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
H_{FE}	直流电流增益	100		320		$V_{CE}=2V, I_C=500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			2.0	V	$I_C=1.5A, I_B=0.03A$
V_{BE}	基极—发射极电压			1.0	V	$V_{CE}=2V, I_C=500mA$
f_T	特征频率		120		MHz	$V_{CE}=2V, I_C=500mA$
C_{ob}	共基极输出电容			30	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$

分档及其标志

分档标志	分档范围
O	100—200
Y	160—320